



**BDY58R: Transistor Npn Silicon Diffused
Mesa 125V 25A**



Descripción

Nombre: TRANSISTOR NPN SILICON DIFFUSED MESA TRANSISTOR NPN DE SILICIO (TECNOLOGÍA MESA) **Referencia:** BDY58R

- Polaridad del transistor: NPN
- Configuración: Single
- Corriente CC máxima de colector: 25A
- Máx. voltaje VCEO colector-emisor: 125V
- Tensión VCBO colector-base: 160V
- Voltaje VEBO emisor-base: 10V
- Voltaje de saturación colector-emisor: 0.5V
- Dp - Disipación de potencia: 175W
- Producto para ganar Ancho de banda fT: 30 MHz
- Temperatura de trabajo: desde -65°C hasta 200°C

Marca: ASI **Empaque:** TO-3 **Precio por:** Unidad **Ficha Técnica:** [BDY58R](#)

Información del producto

Descripción: TRANSISTOR NPN SILICON DIFFUSED MESA. Marca: ASI. Referencia: BDY58R
El BDY58R es un transistor de unión bipolar (BJT) NPN de alta potencia diseñado para aplicaciones que requieren alta corriente y voltaje. Se utiliza comúnmente en fuentes de alimentación, amplificadores de audio y circuitos de conmutación.

Precio: \$1.850 IVA INCLUIDO

SKU: 9-5-159

Categorías: [SEMICONDUCTORES](#), [TRANSISTORES Y REGULADORES](#)

Etiquetas: [0090005000159](#), [9-5-159](#), [ASI](#), [BDY58R](#), [datasheet](#), [pinout](#), [SEMICONDUCTORES](#), [Through Hole](#), [TRANSISTOR NPN SILICON DIFFUSED MESA](#), [TRANSISTORES Y REGULADORES](#)



BDY58 - BDY58

NPN SILICON TRANSISTORS, DIFFUSED MESA

UP: Large Signal Power Amplification
High Collector-Emitter Voltage

ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS

Symbol	Parameter	Value	Unit
V _{CEO}	Collector-Emitter Voltage	125	V
V _{CE0}	Collector-Base Voltage	160	V
V _{EB0}	Emitter-Base Voltage	10	V
V _{CE(sat)}	Collector-Emitter Voltage	0.5	V
I _C	Collector Current	25	A
I _E	Emitter Current	25	A
P _{tot}	Power Dissipation	175	W
T _j	Junction Temperature	200	°C
T _{stg}	Storage Temperature	-65 to 200	°C

THERMAL CHARACTERISTICS

Symbol	Parameter	Value	Unit
R _{th(j-c)}	Thermal Resistance, Junction to Case	1	°C/W

COMSE SEMICONDUCTORS